

## 16К (2Кх8) РЕПРОГРАММИРУЕМОЕ ПЗУ С УЛЬТРАФИОЛЕТОВЫМ СТИРАНИЕМ ИНФОРМАЦИИ

НМОП технология

Репрограммируемое постоянное запоминающее устройство с УФ-стиранием информации обеспечивает возможность долговременного хранения информации при включенном и отключенном питании.

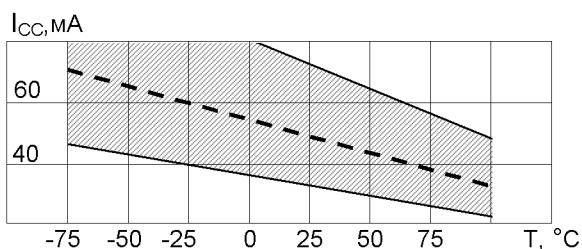
- время выборки адреса 450нс;
- напряжение питания  $5В \pm 5\%$ ;
- напряжение сигнала записи-считывания в момент программирования  $24,5В \pm 0,5В$ ;
- допустимое значение статического потенциала не более 200В.



### НАДЕЖНОСТЬ

Наработка, ч	$t_{и}$	50 000
Интенсивность отказов 1/ч	$\lambda_{и}$	$1 \cdot 10^{-6}$
Срок хранения, лет	$t_{хр}$	12

### ОБЛАСТЬ ИЗМЕНЕНИЯ $I_{CC}$ ОТ T



### НАЗНАЧЕНИЕ ВЫВОДОВ

1- 8, 19, 22, 23	A1-A11	Вход адресный
9 -11, 13 -17	D1-D8	Вход-выход
12	OV	Общий
18	$U_{\overline{CE}}$	Вход сигнала разрешения обращения
20	$U_{\overline{OE}}$	Вход сигнала разрешения выхода
21	WR/RD	Вход сигнала записи-считывания
24	$U_{CC}$	Источник питания

### ДОПУСТИМЫЕ ВНЕШНИЕ ВОЗДЕЙСТВИЯ

#### МЕХАНИЧЕСКИЕ

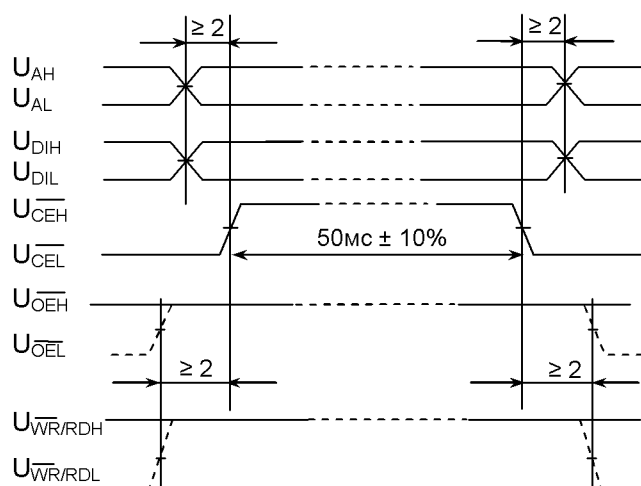
Механические удары, g	150
Линейное ускорение, g	500
Вибрация 1 - 2 000 Гц, g	20
Устойчивость к воде и спирто-бензиновой смеси	1:1

#### КЛИМАТИЧЕСКИЕ

Диапазон рабочих температур, °C	от - 45 до 70
Изменение температуры среды, °C	от - 60 до 85
Повышенная влажность при $T = 35$ °C, %	до 98
Температура пайки, °C	$235 \pm 5$
Продолжительность, с	$2 \pm 0,5$

**ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ** ( $U_{CC} = 5 \text{ В} \pm 5\%$ )

Символ	Параметр	T, °C	K573PФ2
$U_{DOL}$	Напряжение выхода низкого уровня, В ( $I_{OL} = 2,1 \text{ мА}$ )	25, - 45 70	$\leq 0,40$ $\leq 0,45$
$U_{DOH}$	Напряжение выхода высокого уровня, В ( $I_{OH} = 0,4 \text{ мА}$ )	от - 45 до 70	$\geq 2,4$
$I_{CC}$	Ток потребления в режиме считывания, мА	25, 70 - 45	$\leq 80$ $\leq 100$
$I_{CCS}$	Ток потребления в режиме хранения, мА	25, 70 - 45	$\leq 20$ $\leq 25$
$I_{WR/RD}$	Ток сигнала записи - считывания, мА	25, 70 - 45	$\leq 6$ $\leq 10$
$I_{WR/RDS}$	Ток сигнала записи – считывания в режиме хранения, мА	от - 45 до 70	$\leq 2$
$I_{LI}$	Ток утечки по каждому входу, мкА	от - 45 до 70	$\leq 10$
$t_{A(A)}$	Время выборки адреса, мкс	от - 45 до 70	$\leq 0,45$
$t_{A(CE)}$	Время выборки разрешения обращения, мкс	от - 45 до 70	$\leq 0,45$
$t_{A(OE)}$	Время выборки разрешения выхода, мкс	от - 45 до 70	$\leq 0,20$
$t_{SG1}$	Время хранения информации при отключённом питании, ч	от - 45 до 70	$\geq 100\ 000$
$t_{SG2}$	Время хранения информации при включённом питании, ч	от - 45 до 70	$\geq 50\ 000$
$C_I$	Входная ёмкость выводов микросхем, пФ	$25 \pm 10$	$\leq 8$
$N_{CY}$	Количество циклов перепрограммирования, цикл	$25 \pm 10$	$\geq 100$

**ДИАГРАММА РЕЖИМА ЗАПИСИ**


Допускается объединение микросхем по входам и выходам.

Микросхемы пригодны для монтажа в аппаратуре методом групповой пайки или паяльником.

Стирание информации проводят путём воздействия потока ультрафиолетового излучения длиной волны  $\lambda=253,7 \text{ нм}$ , с энергетической экспозицией  $1,5 \cdot 10^5 \text{ Вт} \cdot \text{с}/\text{м}^2$ .

Ток потребления от сигнала записи-считывания ( $I_{WR/RDH}$ ) в момент программирования может достигать 30 мА (импульсный), а в режиме запрета программирования или контроля после программирования – не более 6,0 мА.